

ПРОТОКОЛ № 2/2019
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного автономного научного учреждения
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

г. Москва

28 августа 2019 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии	- доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН - С.А.Гамкрелидзе
Заместитель председателя комиссии	- кандидат физико-математических наук, доцент заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН - Д.С. Пономарев
Секретарь комиссии	- кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН - Р.А. Хабибуллин
Члены комиссии:	- кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов - доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» - Ю.В. Колковский - член-корреспондент РАН, директор ФТИАН имени В.К.Валиева РАН - В.Ф. Лукичев - главный научный сотрудник, профессор кафедры Электроники НИЯУ «МИФИ», доктор технических наук - Д.В.Громов

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня: Проведение конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 103 «Лаборатория исследования и разработки МЛЭ технологии наногетероструктурных квантовых ям и мощных СВЧ-транзисторов на их основе».

Слушали:

1. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса, от Глинского Игоря Андреевича для избрания его на должность научного сотрудника лаборатории исследования и разработки МЛЭ технологии наногетероструктурных квантовых ям и мощных СВЧ-транзисторов на их основе. Директор зачитал характеристику Глинского И.А., подписанную заместителем директора по научной работе Пономаревым Д.С. В ней, в частности отмечается, что Глинский И.А. является специалистом в области разработки и проектирования источников и детекторов ТГц излучения. Им выполнялись различные исследовательские задачи как экспериментального, так и теоретического характера: проводил численное моделирование

тепловых процессов в транзисторах с высокой подвижностью электронов на основе материалов АЗВ5 и в ТГц квантово-каскадных лазерах, а также электромагнитное моделирование и проектирование фотопроводящих источников ТГц излучения.

Глинский И.А. является соавтором 19 статей в ведущих научных журналах. Результаты исследований неоднократно представлялись на отечественных и международных научных конференциях и семинарах. В процессе работы в ИСВЧПЭ РАН он проявил себя как квалифицированный специалист в области разработки и проектирования источников и детекторов ТГц излучения.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам.

2. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, на сайте [www.ученые – исследователи.рф](http://www.ученые-исследователи.рф) поступила заявка от Зенченко Николая Владимировича 1991 г.р. для избрания по конкурсу на должность научного сотрудника лаборатории исследования и разработки МЛЭ технологии наногетероструктурных квантовых ям и мощных СВЧ-транзисторов на их основе.

Однако в Конкурсную комиссию был представлен не полный пакет документов, в связи с этим членами Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию претендента Зенченко Н.В.

Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 1-му пункту повестки дня:

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 103 лаборатории исследования и разработки МЛЭ технологии наногетероструктурных квантовых ям и мощных СВЧ-транзисторов на их основе состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании бальной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- научного сотрудника лаборатории исследования и разработки МЛЭ технологии наногетероструктурных квантовых ям и мощных СВЧ-транзисторов на их основе – Глинского Игоря Андреевича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор
Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.-м.н.

«28» августа 2019 г.



С.А. Гамкрелидзе

Р.А. Хабибуллин